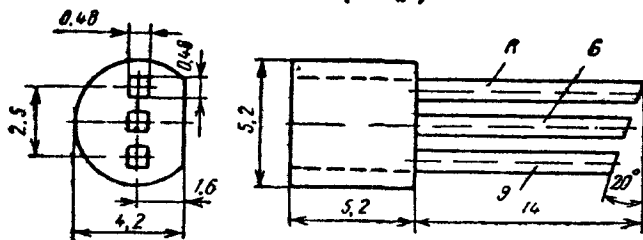


КТ502 (А, Б, В, Г, Д, Е)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных дифференциальных и импульсных усилителях, преобразователях. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

КТ502 (А-Е)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{кв}=5$ В, $I_B=10$ мА:

КТ502А, КТ502В, КТ502Д, КТ502Е	40...120
КТ502Б, КТ502Г	80...240

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кв}=5$ В, $I_B=3$ мА, не менее

Граничное напряжение при $I_B=10$ мА, $t_u \leq 30$ мкс, $Q \geq 100$, не менее:

КТ502А, КТ502Б	25 В
КТ502В, КТ502Г	40 В
КТ502Д	60 В
КТ502Е	80 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_B=1$ мА, не более

типичное значение 0,6 В
0,15* В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_k=10$ мА, $I_B=1$ мА, не более

типичное значение 1,2 В
0,8* В

Обратный ток коллектора при $U_{кв}=U_{кв, макс}$, не более

типичное значение 1 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{кв}=5$ В, $f=$

типичное значение 465 кГц, не более 20 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

КТ502А, КТ502Б	40 В
КТ502В, КТ502Г	60 В
КТ502Д	80 В
КТ502Е	90 В

Постоянное напряжение база — эмиттер 5 В

Постоянный ток коллектора 0,15 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мс, $Q \geq 100$ 0,35 А

Постоянный ток базы 0,1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 0,35 Вт

Температура *p-n* перехода +125 °С

Температура окружающей среды - 40 +85 °С

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5 2 мм; при этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. При пайке жало паяльника должно быть заземлено.